

**Қ. Жұбанов атындағы Ақтобе университетінің Физика кафедрасының оқытушысы
Дуйсенова Айнур Гайсиевнаның ғылыми еңбектерінің
ТІЗІМІ**

**СПИСОК
научных трудов преподавателя кафедры Физики Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова
Дуйсеновой Айнур Гайсиевны**

№	Еңбектің атауы. Название труда	Жұмыс сипаты. Характеристика работы	Баспа, журнал, конференция (атауы, №, жылы), авторлық куәліктің №. Издательство, журнал, конференция (название, №, год), № авторского свидетельства, патент	Көлемі (б.т.) Объем (п.л.)	Серіктес авторы Соавторы
1	2	3	4	5	6
Scopus/Web of Science мәліметтер базасына енгізілген жарияланымдар. Публикации, входящие в базу данных Scopus/Web of Science					
1	Electron Transport in Model Quasi-Two-Dimensional van der Waals Nanodevices (Электронный транспорт в модельных квазидвумерных ван-дер-ваальсовых наноструктурах)	Печат. (статья)	Technical Physics Letters. – 2021. – Vol. 47(4). – P. 375–378. (Письма в Журнал технической физики. – 2021. – Т. 47. – №. 8. – С. 7-10.) DOI:10.1134/S1063785021040295 (10.21883/PJTF.2021.08.50844.18583)	0,25	Sergeyev D. (Сергеев Д.М.)
2	Electron transport in «core-shell» type fullerene nanojunction	Печат. (статья)	Advances in Nano Research. – 2022. – Vol. 12(1). – P. 25-35. DOI:10.12989/anr.2022.12.1.025	0,6875	Sergeyev D.

Ізденуші:
Соискатель:

Бас ғылыми хатшы:
Главный ученый секретарь:



А.Г. Дуйсенова

Н.К. Култанбаева

	2	3	4	5	6
3	Electron transport in a stressed moir'e bigraphene structure	Печат. (статья)	Results in Physics. – 2023. – Vol. 54. – P. 107140. DOI: 10.1016/j.rinp.2023.107140	0,5	Sergeyev D., Solovjov A., Ismayilova N.
Авторлық куәлік, патент. Авторское свидетельство, патент.					
4	Патент РК на полезную модель: «Нанодиод»	-	№7120 РК от 20.05.2022	-	Сергеев Д.М.
Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар. Публикации в материалах международных конференций					
5	Model of single-electron transistor based on prismanes	Печат. (статья)	10th International conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems. INESS-2022. Materials Today: Proceedings. - 2022. – Vol.81. – P. 1192-1197. DOI: 10.1016/j.matpr.2022.11.175	0,375	Sergeyev D.
6	Model of a single-electron transistor based on endohedral fullerene (Sc ₃ N)@C ₈₀ (Модель одноэлектронного транзистора на основе эндодрального фуллерена (Sc ₃ N)@C ₈₀)	Печат. (статья)	9-ая Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы радиофизики», АПР-2021. Journal of Physics Conference Series. – 2021, Vol.2140. – P. 012006. (Актуальные проблемы радиофизики АПР-2021. – 2021. – С. 148-151) DOI:10.1088/1742-6596/2140/1/012006	0,3125	Sergeyev D. (Сергеев Д.М.)

Ізденуші:
Соискатель:

Бас ғылыми хатшы:
Главный ученый секретарь:



А.Г. Дуйсенова

Н.К. Култанбаева